

Arş.Gör.Dr. OZAN ÖZTÜRK

Kişisel Bilgiler

E-posta: ozanozturk@cumhuriyet.edu.tr

Web: <https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/ozanozturk>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0002-9592-3152

ScopusID: 57199406022

Yoksis Araştırmacı ID: 255311



Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanobilim ve Nanomühendislik,
Türkiye 2019 - 2024

Ön Lisans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik
Pr., Türkiye 2022 - 2023

Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Bilgisayar Programcılığı Pr., Türkiye
2021 - 2023

Yüksek Lisans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji
Mühendisliği, Türkiye 2016 - 2018

Lisans Çift Anadal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği,
Türkiye 2012 - 2016

Lisans, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Türkiye 2011 - 2015

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Nikel Sülfür Tabanlı Hibrit Süperkapasitör Aygıt Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Nanobilim ve Nanomühendislik, 2024

Yüksek Lisans, Üçlü GaAlAs/GaAs ve GaInAs/GaAs Nano Yapıların Elektronik Özellikleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2018

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2024 - Devam

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Layered Transition Metal Sulfides for Supercapacitor Applications**
ÖZTÜRK O., GÜR E.
ChemElectroChem, 2024 (SCI-Expanded)
- II. **High harmonic generations triggered by the intense laser field in GaAs/Al_xGa_{1-x}As honeycomb quantum well wires**
Alaydin B. Ö., Altun D., Öztürk O., Öztürk E.
Materials Today Physics, cilt.38, 2023 (SCI-Expanded)
- III. **High harmonic generations in GaAs/AlGaAs superlattice: Effect of electric and magnetic field**
Öztürk E., Altun D., Öztürk O., Alaydin B. Ö.
Solid State Communications, cilt.372, 2023 (SCI-Expanded)
- IV. **Linear and nonlinear optical properties of a superlattice with periodically increased well width under electric and magnetic fields**
ALTUN D. D., ÖZTÜRK O., ALAYDİN B. Ö., ÖZTÜRK E.
MICRO AND NANOSTRUCTURES, cilt.166, 2022 (SCI-Expanded)
- V. **Intense laser field effect on the nonlinear optical properties of triple quantum wells consisting of parabolic and inverse-parabolic quantum wells**
Öztürk O., Alaydin B. Ö., Altun D., Öztürk E.
Laser Physics, cilt.32, sa.3, 2022 (SCI-Expanded)
- VI. **Depending on the intense laser field of the nonlinear optical rectification, second and third harmonic generation in asymmetric parabolic-step and inverse parabolic-step quantum wells**
ÖZTÜRK O., ÖZTÜRK E., Elagoz S.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.94, sa.11, 2019 (SCI-Expanded)
- VII. **The effect of intense laser field on the nonlinear optical features in asymmetric multiple step and inverse V-shaped multiple step quantum wells**
Öztürk O., Öztürk E., Elagoz S.
LASER PHYSICS, cilt.29, 2019 (SCI-Expanded)
- VIII. **Dependence on well widths of total optical absorption coefficient of asymmetric triple GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells**
ÖZTÜRK O., ÖZTÜRK E., Elagoz S.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.33, sa.17, 2019 (SCI-Expanded)
- IX. **Nonlinear Optical Rectification, Second and Third Harmonic Generations in Square-Step and Graded-Step Quantum Wells under Intense Laser Field**
Ozturk O., Ozturk E., Elagoz S.
CHINESE PHYSICS LETTERS, cilt.36, sa.6, 2019 (SCI-Expanded)
- X. **Linear and nonlinear optical properties of asymmetric triple quantum wells under intense laser field**
Ozturk O., Ozturk E., Elagoz S.
LASER PHYSICS, cilt.29, sa.5, 2019 (SCI-Expanded)
- XI. **Linear and nonlinear optical absorption coefficient and electronic features of triple GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells depending on barrier widths**
Ozturk O., Ozturk E., Elagoz S.
OPTIK, cilt.180, ss.394-405, 2019 (SCI-Expanded)
- XII. **The effect of barrier width on the electronic properties of double GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells**
Ozturk O., Ozturk E., Elagoz S.
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1156, ss.726-732, 2018 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

- I. **Electronic characteristics of asymmetric triple GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells depending on Al and In concentration**
ÖZTÜRK O., ÖZTÜRK E., ELAGOZ S.
Cumhuriyet Science Journal, cilt.41, sa.3, ss.565-570, 2020 (Hakemli Dergi)
- II. **Electronic properties of double GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantumwells as dependent on well width**
ÖZTÜRK O., ÖZTÜRK E., ELAGOZ S.
Cumhuriyet Science Journal, cilt.40, sa.2, ss.465-470, 2019 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Dependence on Well Widths of the Electronic Features of Triple GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs Quantum Wells**
Öztürk O., Öztürk E., Elagoz S.
5th International Conference on Materials Science and Advanced-Nanotechnologies For Next Generation (MSNG-2018), Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018
- II. **Electronic characteristics of triple GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells depending on Al and In concentration**
Öztürk O., Öztürk E., Elagöz S.
5th International Conference on Materials Science and Advanced-Nanotechnologies For Next Generation (MSNG-2018) , Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.308
- III. **Second-Harmonic Generation Susceptibility in Asymmetric Triple Delta-Doped GaAs Structures**
Öztürk E., Öztürk O., Elagöz S.
5th International Conference on Materials Science and Advanced-Nanotechnologies For Next Generation (MSNG-2018) , Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.309
- IV. **Depending on Al and In concentration of the electronic properties of asymmetric double GaAlAs/GaAs and GaInAs/GaAs quantum wells**
Öztürk O., Öztürk E., Elagöz S.
4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018) , Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.630-635
- V. **The Effect of Barrier Width on the Electronic Properties of Double GaAlAs / GaAs andGaInAs / GaAs Quantum Wells**
Öztürk O., Öztürk E., Elagoz S.
MSNG 2017, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 Haziran 2017, ss.43

Metrikler

Yayın: 19

Atıf (WoS): 28

Atıf (Scopus): 45

H-İndeks (WoS): 3

H-İndeks (Scopus): 4